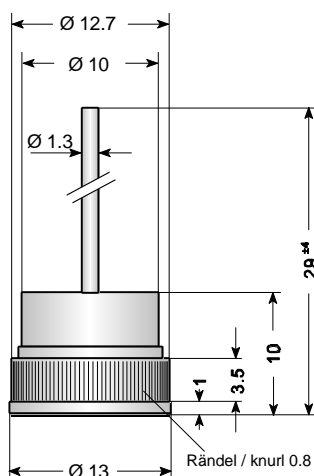


**Silicon Press-Fit-Diodes**  
**High-temperature diodes**
**Silizium-Einpreßdioden**  
**Hochtemperaturdioden**


Dimensions / Maße in mm

|  |           |
|--|-----------|
| Nominal current – Nennstrom  | 25 A      |
| Repetitive peak reverse voltage<br>Periodische Spitzensperrspannung                    | 50..400 V |
| Metal press-fit case with plastic cover<br>Metall-Einpreßgehäuse mit Plastik-Abdeckung |           |
| Weight approx. – Gewicht ca.   | 10 g      |
| Casting compound has UL classification 94V-0<br>Vergußmasse UL94V-0 klassifiziert      |           |
| Standard packaging: bulk<br>Standard Lieferform: lose im Karton                        |           |

**Maximum ratings**
**Grenzwerte**

| Type / Typ<br>Wire at / Draht an |           | Rep. peak reverse voltage<br>Period. Spitzensperrspannung | Surge peak reverse voltage<br>Stoßspitzensperrspannung |
|----------------------------------|-----------|---|--|
| Kathode                          | Anode     | $V_{RRM}$ [V]   | $V_{RSM}$ [V]  |
| BYP 70/25                        | BYP 75/25 | 50  | 60   |
| BYP 71/25                        | BYP 76/25 | 100   | 120  |
| BYP 72/25                        | BYP 77/25 | 200   | 240  |
| BYP 73/25                        | BYP 78/25 | 300   | 360  |
| BYP 74/25                        | BYP 79/25 | 400   | 480  |

|   |                           |           |                      |
|---|---------------------------|-----------|----------------------|
| Max. average forward rectified current, R-load<br>Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last | $T_C = 150^\circ\text{C}$ | $I_{FAV}$ | 25 A                 |
| Repetitive peak forward current<br>Periodischer Spitzenstrom                                    | $f > 15 \text{ Hz}$       | $I_{FRM}$ | 90 A <sup>1)</sup>   |
| Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$<br>Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$                | $T_A = 25^\circ\text{C}$  | $i^2t$    | 375 A <sup>2</sup> s |
| Peak fwd. surge current, 60 Hz half sine-wave<br>Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen      | $T_A = 25^\circ\text{C}$  | $I_{FSM}$ | 300 A                |

<sup>1)</sup> Valid, if the temperature of the case is kept to 150°C – Gültig, wenn die Gehäusetemperatur auf 150°C gehalten wird

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur  $T_j$  – 50...+215 °C  
 Storage temperature – Lagerungstemperatur  $T_s$  – 50...+215 °C

Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck 7 kN

**Characteristics** **Kennwerte**

Forward voltage  $T_j = 25^\circ\text{C}$   $I_F = 25 \text{ A}$   $V_F$  < 1.1 V  
 Durchlaßspannung

Leakage current  $T_j = 25^\circ\text{C}$   $V_R = V_{RRM}$   $I_R$  < 100  $\mu\text{A}$   
 Sperrstrom

Thermal resistance junction to case  $R_{thC}$  < 1 K/W  
 Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse

